

2017年6月8日

報道関係者各位

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20

ディーアイシービル

DIC 開発品が『半導体・オブ・ザ・イヤー半導体用電子材料部門優秀賞』を受賞
半導体製造の次世代プロセス「ナノインプリント技術」に対応したレジスト用樹脂を開発

DIC株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：中西義之）が開発した「半導体製造の次世代プロセス『ナノインプリント（NIL）技術』に対応したレジスト用樹脂」が、電子デバイス産業新聞（株式会社産業タイムズ社発行）が主催する「半導体・オブ・ザ・イヤー2017 半導体用電子材料部門優秀賞」を受賞しました。6月7日には、「電子機器 2017 トータルソリューション展」（於：東京ビッグサイト）において、表彰式と受賞者による製品プレゼンテーションが行われました。



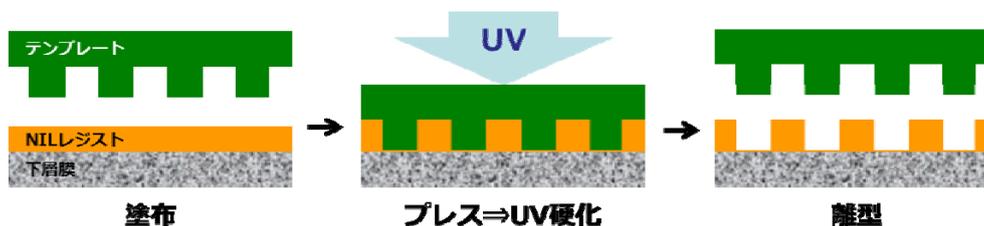
矢田真主任研究員によるプレゼンテーション



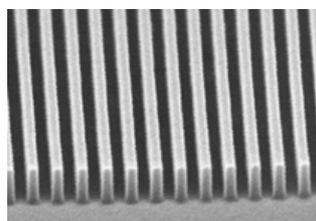
開発に携わったメンバー

「半導体・オブ・ザ・イヤー」は、重要性を増している最先端のIT機器・産業を支える半導体製品・技術を表彰することで、業界の技術および市場のさらなる発展に寄与することを目的として1994年に創設され、今回で第23回を迎えます。2016年4月～2017年3月の間に新製品として発表された製品・技術、および電子デバイス産業新聞の紙面で紹介された新製品の中から同紙記者の推薦、自由応募を含めて候補製品・技術を選出し、投票されました。賞には、半導体デバイス部門、半導体製造装置部門、半導体用電子材料部門があり、それぞれにグランプリと優秀賞が設けられています。

NILプロセスは、ナノスケールの微細な凹凸を施したパターンを有するテンプレートと呼ばれる型（原版）を、事前に基板上に塗布したUV硬化型レジストに押し当て、型取りし、UV照射により硬化させることで微細パターンのエッチングマスクを形成させる次世代微細加工技術です。



UV硬化を利用したNILプロセス



NILプロセスにより作製した開発樹脂の微細パターンの一例
(ハーフピッチ；45nm、高さ；100nm)

今回受賞した開発品は、UV硬化型有機無機複合樹脂をベースとし、レジストマスクとして必要なドライエッチング耐性（プラズマ中の反応性ガスへの耐性）を高めるとともに、下地への濡れ性および密着性、優れた光硬化性、そして離型性など、NILプロセスに最適化した樹脂です。このたび、これらの優れた性能とNIL実現にむけたソリューションとしての新規性と将来性が高く評価され、優秀賞に選ばれました。

当社では、引き続き他社に先駆け最先端プロセスに適応した機能性材料を供給していくことで、技術革新が継続する同市場を材料の面から支えていきたいと考えています。

以上

■□■受賞した開発品情報□■□（2016年12月20日付 当社ニュースリリース）

「半導体製造の次世代プロセス『ナノインプリント技術』に対応したレジスト用樹脂の開発」

http://www.dic-global.com/ja/release/2016/20161220_01.html

報道機関からのお問い合わせ コーポレートコミュニケーション部

TEL 03-6733-3033

お客様からのお問い合わせ 精密化学品営業部

TEL 03-6733-5933